


발송번호 : 9-5-2005-003135676

발송일자 : 2005.01.24

제출기일 : 2005.03.24

심사관	담당관	국 장	보 고
			

특허청 의견제출통지서

출원인 **명칭** 삼성에스디아이 주식회사 (출원인코드: 119980018058)
주 소 경기 수원시 영통구 신동 575
대리인 **성명** 박상수
주 소 서울 강남구 역삼동 832-7 황화빌딩 1810호 (성우국제특허법률사무소)
출원번호 10-2003-0024431
발명의 명칭 박막 트랜지스터 및 그의 제조 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이 유]

이 출원의 특허청구범위 제1-7항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

본원의 청구범위 제1-7항은 박막트랜지스터 및 그 제조방법에 관한 것으로, 기판 상에 버퍼층, 활성층, 게이트절연막을 차례로 형성하되, 버퍼층은 활성층 하부의 부분과 그 이외의 부분간에 단차가 지며, 단차는 활성영역과 게이트절연막의 두께의 합의 1/2이하인 것 등을 특징으로 하나 이는 인용발명1(일본특개2001-320062호)에 개시된, 반도체층과 게이트전극 사이의 게이트절연막이 소스/드레인이 형성될 부분보다 게이트전극이 형성되는 부분의 두께가 1.2배~8배가 되도록 형성한 박막트랜지스터 제조방법과, 인용발명2(일본특개2002-33330호)의 도면 제6도에 개시된, 기판 위에 형성하는 절연막의 두께를 단차지게 형성하는 공정을 갖는 반도체장치 제조방법으로부터 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있습니다.

[참 부]

첨부1 일본공개특허공보 평13-320062호(2001.11.16) 1부.

첨부2 일본공개특허공보 평14-033330호(2002.01.31) 1부. 끝.

2005.01.24

특허청 전기전자심사국

응용소자심사담당관실

심사관 임동우



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5750 로 문의하시기 바랍니다.

서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 콜센터 ☎1544-8080으로 문의하시기 바랍니다.